

CDM7-650

**SURFACE MOUNT SILICON
N-CHANNEL
MEDIUM POWER MOSFET
7.0 AMP, 650 VOLT**



DPAK CASE



www.centrasemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CDM7-650 is a 650 volt N-Channel MOSFET designed for high voltage, fast switching applications such as Power Factor Correction (PFC), lighting and power inverters. This MOSFET combines high voltage capability with low $r_{DS(ON)}$, low threshold voltage, and low gate charge for optimal efficiency.

MARKING: FULL PART NUMBER

APPLICATIONS:

- Power Factor Correction
- Alternative energy inverters
- Solid state lighting

FEATURES:

- High voltage capability ($V_{DS}=650V$)
- Low gate charge ($Q_{gs}=5.0nC$)
- Low $r_{DS(ON)}$ (1.35Ω)

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^\circ C$ unless otherwise noted)

	SYMBOL		UNITS
Drain-Source Voltage	V_{DS}	650	V
Gate-Source Voltage	V_{GS}	30	V
Continuous Drain Current (Steady State)	I_D	7.0	A
Maximum Pulsed Drain Current, $t_p=10\mu s$	I_{DM}	28	A
Continuous Source Current (Body Diode)	I_S	7.0	A
Maximum Pulsed Source Current (Body Diode)	I_{SM}	28	A
Single Pulse Avalanche Energy (Note 1)	E_{AS}	435	mJ
Power Dissipation	P_D	1.12	W
Power Dissipation ($T_C=25^\circ C$)	P_D	140	W
Operating and Storage Junction Temperature	T_J, T_{stg}	-55 to +150	$^\circ C$
Thermal Resistance	θ_{JC}	0.89	$^\circ C/W$
Thermal Resistance	θ_{JA}	110	$^\circ C/W$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_A=25^\circ C$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
I_{GSSF}, I_{GSSR}	$V_{GS}=30V, V_{DS}=0$		10	100	nA
I_{DSS}	$V_{DS}=650V, V_{GS}=0$		0.03	1.0	μA
BV_{DSS}	$V_{GS}=0, I_D=250\mu A$	650			V
$V_{GS(th)}$	$V_{GS}=V_{DS}, I_D=250\mu A$	2.0	2.88	4.0	V
V_{SD}	$V_{GS}=0, I_S=7.0A$		0.88	1.4	V
$r_{DS(ON)}$	$V_{GS}=10V, I_D=3.5A$		1.35	1.5	Ω
C_{rss}	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0, f=1.0MHz$		0.8		pF
C_{iss}	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0, f=1.0MHz$		754		pF
C_{oss}	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0, f=1.0MHz$		97		pF

Notes: (1) $L=30mH, I_{AS}=5.25A, V_{DD}=50V, R_G=25\Omega$, Initial $T_J=25^\circ C$

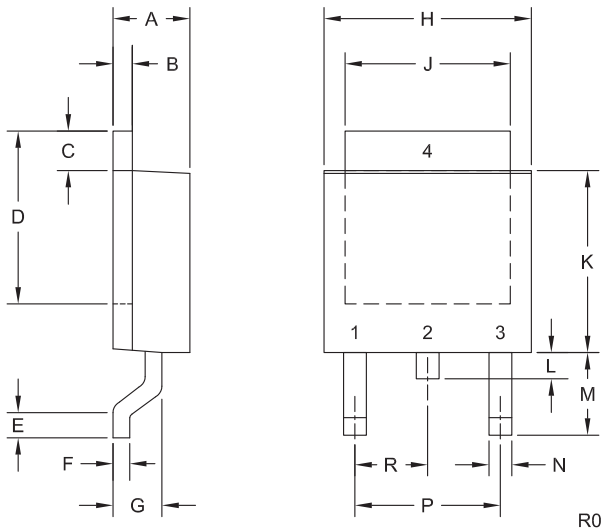
R2 (2-July 2014)

CDM7-650

**SURFACE MOUNT SILICON
N-CHANNEL
MEDIUM POWER MOSFET
7.0 AMP, 650 VOLT**

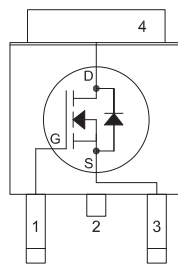
**ELECTRICAL CHARACTERISTICS - Continued:** ($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	TYP	UNITS
$Q_{g(\text{tot})}$	$V_{DS}=520\text{V}$, $V_{GS}=10\text{V}$, $I_D=7.0\text{A}$ (Note 2)	16.8	nC
Q_{gs}	$V_{DS}=520\text{V}$, $V_{GS}=10\text{V}$, $I_D=7.0\text{A}$ (Note 2)	5.0	nC
Q_{gd}	$V_{DS}=520\text{V}$, $V_{GS}=10\text{V}$, $I_D=7.0\text{A}$ (Note 2)	6.0	nC
t_d	$V_{DD}=325\text{V}$, $I_D=7.0\text{A}$, $R_G=25\Omega$ (Note 2)	14	ns
t_r	$V_{DD}=325\text{V}$, $I_D=7.0\text{A}$, $R_G=25\Omega$ (Note 2)	28	ns
t_s	$V_{DD}=325\text{V}$, $I_D=7.0\text{A}$, $R_G=25\Omega$ (Note 2)	38	ns
t_f	$V_{DD}=325\text{V}$, $I_D=7.0\text{A}$, $R_G=25\Omega$ (Note 2)	28	ns
t_{rr}	$V_{GS}=0$, $I_S=7.0\text{A}$, $di/dt=100\text{A}/\mu\text{s}$ (Note 2)	493	ns
Q_{rr}	$V_{GS}=0$, $I_S=7.0\text{A}$, $di/dt=100\text{A}/\mu\text{s}$ (Note 2)	2.99	μC

Notes: (2) Pulse Width $\leq 300\mu\text{s}$, Duty Cycle $\leq 2\%$ **DPAK CASE - MECHANICAL OUTLINE**

SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.083	0.108	2.10	2.75
B	0.016	0.032	0.40	0.81
C	0.035	0.063	0.89	1.60
D	0.203	0.228	5.15	5.79
E	0.020	-	0.51	-
F	0.018	0.024	0.45	0.60
G	0.051	0.071	1.30	1.80
H	0.248	0.268	6.30	6.81
J	0.197	0.217	5.00	5.50
K	0.209	0.245	5.30	6.22
L	0.025	0.040	0.64	1.02
M	0.090	0.115	2.30	2.91
N	0.012	0.045	0.30	1.14
P	0.180		4.60	
R	0.090		2.30	

DPAK (REV: R0)

PIN CONFIGURATION**LEAD CODE:**

- 1) Gate
 - 2) Drain
 - 3) Source
 - 4) Drain
- Pin 2 is common to the tab (4)

MARKING: FULL PART NUMBER

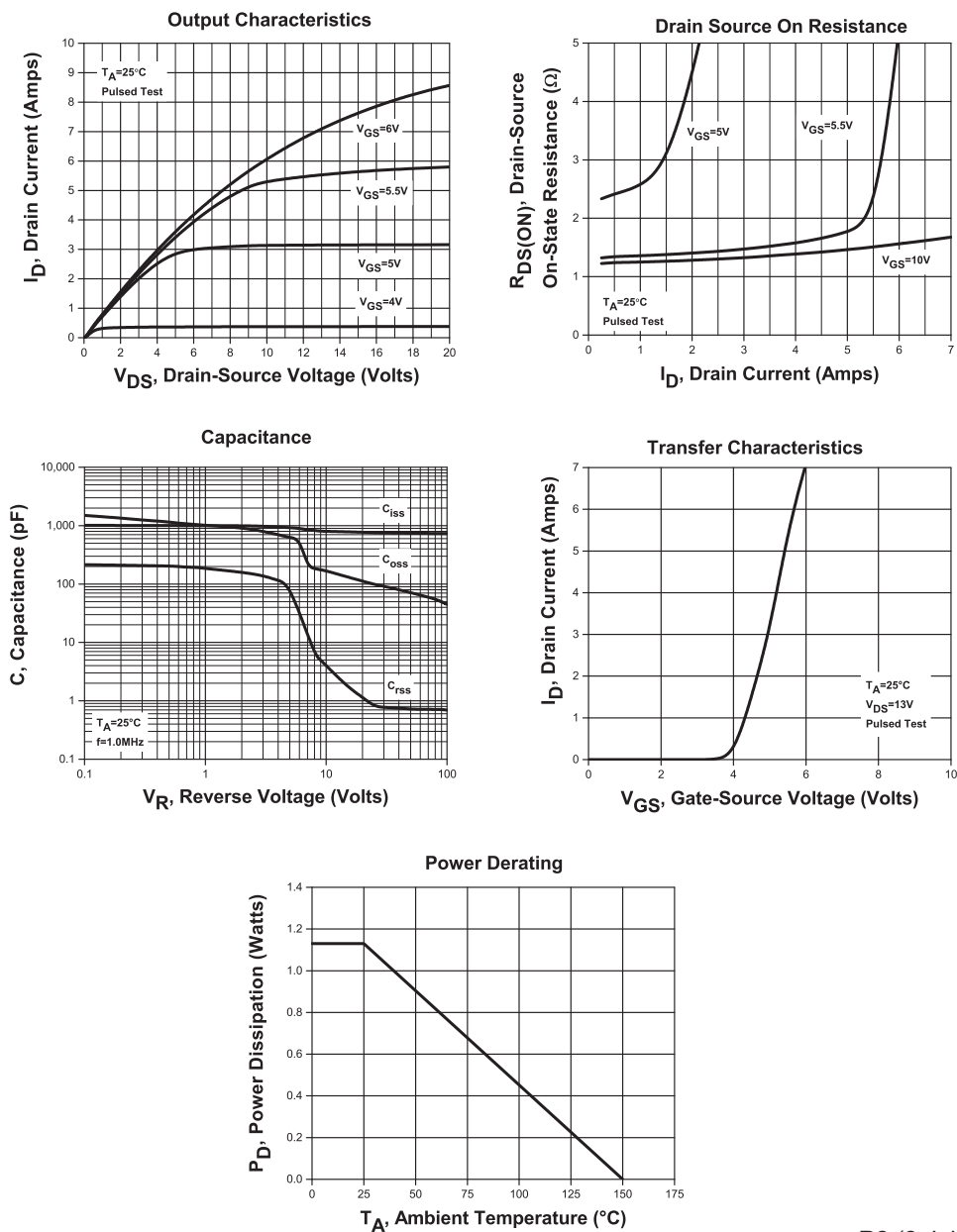
R2 (2-July 2014)

CDM7-650

SURFACE MOUNT SILICON
N-CHANNEL
MEDIUM POWER MOSFET
7.0 AMP, 650 VOLT



TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS



R2 (2-July 2014)

PRODUCT SUPPORT

Central's operations team provides the highest level of support to insure product is delivered on-time.

- Supply management (Customer portals)
- Inventory bonding
- Consolidated shipping options
- Custom bar coding for shipments
- Custom product packing

DESIGNER SUPPORT/SERVICES

Central's applications engineering team is ready to discuss your design challenges. Just ask.

- Free quick ship samples (2nd day air)
- Online technical data and parametric search
- SPICE models
- Custom electrical curves
- Environmental regulation compliance
- Customer specific screening
- Up-screening capabilities
- Special wafer diffusions
- PbSn plating options
- Package details
- Application notes
- Application and design sample kits
- Custom product and package development

CONTACT US

Corporate Headquarters & Customer Support Team

Central Semiconductor Corp.
145 Adams Avenue
Hauppauge, NY 11788 USA
Main Tel: (631) 435-1110
Main Fax: (631) 435-1824
Support Team Fax: (631) 435-3388
www.centrasemi.com

Worldwide Field Representatives:
www.centrasemi.com/wwreps

Worldwide Distributors:
www.centrasemi.com/wwdistributors

For the latest version of Central Semiconductor's **LIMITATIONS AND DAMAGES DISCLAIMER**, which is part of Central's Standard Terms and Conditions of sale, visit: www.centrasemi.com/terms

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9